
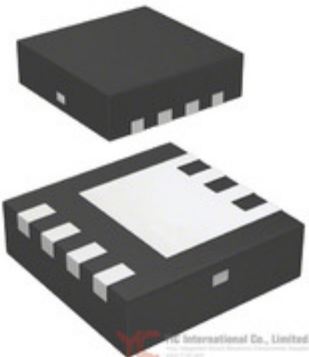







	<p>SISS67DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SISS67DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CHAN 30V POWERPAK 1212-</p> <p>Datenblätter:  SISS67DN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SISS67DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CHAN 30V POWERPAK 1212-
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S
Serie	TrenchFET® Gen III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	65.8W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S
Andere Namen	SISS67DN-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4380pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	111nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 60A (Tc) 65.8W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SISS67DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISS67DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISS67DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SISS67DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SISS42DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK 1212</p>	 <p>SISS62DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SISS62DN-T1-GE3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SISS70DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 125V</p>
 <p>SISS72DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V</p>	 <p>SISS71DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SISS65DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V PPAK 1212-8S</p>	 <p>SISS71DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 23A 1212-8S</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SISS67DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SISS67DN-T1-GE3 Datenblatt	SISS67DN-T1-GE3-Datenblätter	SISS67DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SISS67DN-T1-GE3
SISS67DN-T1-GE3 Electronic	SISS67DN-T1-GE3-Komponenten	SISS67DN-T1-GE3-Verteiler	SISS67DN-T1-GE3-Bild	SISS67DN-T1-GE3-Teil
SISS67DN-T1-GE3 Preis	SISS67DN-T1-GE3 Hersteller	SISS67DN-T1-GE3 Bild	SISS67DN-T1-GE3 Aktie	SISS67DN-T1-GE3 Inventar
SISS67DN-T1-GE3 Neu	SISS67DN-T1-GE3 Original	SISS67DN-T1-GE3 garantiert	SISS67DN-T1-GE3 RFQ	SISS67DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited